

시뮬레이션을 이용한 SF₆-Ar혼합기체의 전리계수

김상남
시립 인천전문대학

A Simulation of the ionization coefficients in mixtures of SF₆ and Ar

Sang-Nam Kim*
Incheon City College

Abstract - In this dissertation the results of the combined experimental and theoretical studies designed to understand and predict the spatial growth and transport coefficients for electrons in SF₆ and SF₆-Ar mixtures have described.

The transport coefficients for electrons in (0.1[%])SF₆-Ar, (0.5[%])SF₆-Ar, (1.0[%])SF₆-Ar, (3.0[%])SF₆-Ar and (5.0[%])SF₆-Ar mixtures were measured by time-of-flight method, and the electron energy distribution function and the parameters of the velocity and the diffusion were determined by the variation of the collision cross-sections with energy.

1. 서론

최근 국내외적으로 고도 산업과 경제 성장으로 전력 수요가 매년 증가하는 실정이다. 따라서 전력 전송의 고전압 화, 대용량화 및 핵융합 등의 새로운 에너지 기술개발의 기초 과학 연구가 다각적으로 활발히 이루어지고 있는 추세이다. 한편 산업 발전에 따라 전력 계통의 대용량화, 송전 전압의 초고압 화에 의하여 각종 전기 기기에 방전 현상이 증대된 영향을 미치게 되고 환경문제 등 여러 산업 분야에서 방전을 이용하려는 노력이 증가하고 있다. 따라서 기체 방전을 지배하는 Mechanism을 정확히 이해할 필요가 있으며 이를 위하여 이론적, 실험적 수치 해석적으로 많은 연구를 필요로 하고 있다[1]~[4].

이것은 전자 에너지 분포 함수를 갖는 전자군과 하전입자 군과의 충돌 현상으로 나타나는 전리 계수, 부착 계수 및 실효 계수 전자 이동 속도, 중·횡방향의 특성 에너지, 등의 전자 수송 특성의 실험적, 이론적 계산에 의하여 정량적으로 산출한다.

2. 해석방법

몬테칼로법은 2차대전기간 동안에 원자탄 개발을 위한 중성자 수송에 관련된 문제를 해결하기 위한 목적으로 많은 과학자들에 의해 연구, 발전되어왔다. 다양한 응용분야에서의 몬테칼로법 중에서 기체중의 전자의 거동에 관한 몬테칼로 시뮬레이션(MCS)으로는 H. Itoh, M. Musha 및 R. W. L. Thomas, W. R. L. Thomas 에 의해서 최초의 연구가 시작되었다[5].

전계가 존재하는 공간의 방전 메카니즘에 있어서 전자는 전계에 의해서 높은 에너지를 갖게 되지만 전자에너지가 평형상태에 있지 않으므로 전자에너지분포를 추정하기는 매우 어렵다. 따라서 이러한 상태에서 전자 에너지 분포를 산출해내는데 몬테칼로 시뮬레이션은 매우 유용하다.

MCS는 난수(Random Number)를 이용하여 충돌의 종류, 산란후의 방향 및 비행시간 등을 결정하면서 전자의 운동을 반복 추적한다. 또한 전자군의 성질을 조사하기 위한 몬테칼로 법은 전자계 내의 전자 운동 상태와 분자의 충돌 산란 확률을 고려하여 전자, 이온의 상태량을 추적하는 것을 기본으로 하여 입자를 확률 현상의 난수로 모의하는 방법을 말한다. 사용하는 난수는 컴퓨터에서 발생하는 [0~1]사이의 의사난수(Pseudo random number)이다.

3. 전자충돌 단면적

3.1 SF₆의 전자 충돌 단면적

본 연구에 이용한 SF₆의 전자 충돌 단면적은 H. Itoh 와 여러 연구자들의 Set을 사용하였다[6]

이 SF₆의 전자 충돌 단면적은 다른 원자, 분자에 비하여

매우 큰 전자 부착단면적 (Q_{a1}, Q_{a2})이 낮은 에너지영역에 존재하고 또한 해리성 부착단면적 (Q_{a3}, Q_{a4}, Q_{a5})의 Threshold에너지 값은 각각 3.29[eV], 3.95[eV], 1.57[eV]를 이용하였다. 그리고 탄성충돌에 의한 운동량 변환 단면적(Q_m), 여기 단면적(Q_{ex}), 전리 단면적(Q_i), 진동 여기 단면적(Q_v) 및 전충돌 단면적(Q_T) 등의 값을 이용하여 계산하였다.

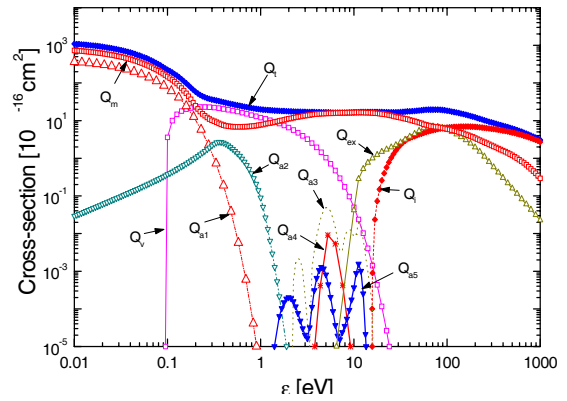


그림 3.1 SF₆기체의 전자 충돌 단면적
Fig.. 3.1 Collision cross sections of electrons in SF₆ gas

3.2 Ar의 전자 충돌 단면적

Ar의 전자 충돌 단면적에 대한 운동량 변환 단면적(Q_m), 여기 단면적(Q_{ex}), 전리 단면적(Q_i)등을 이용하였다.

이 Ar의 전자 충돌 단면적은 저 에너지 영역(0~0.23[eV])에서 Ramsauer Townsend minimum을 갖는 운동량 변환 단면적(Q_m)은 K. L. Bell, N. S. Scott의 계산값을 이용하였고 전자에너지 0.136~54.4[eV] 영역의 범위에서는 W. C. Fon의 측정값을 이용하였다.[7].

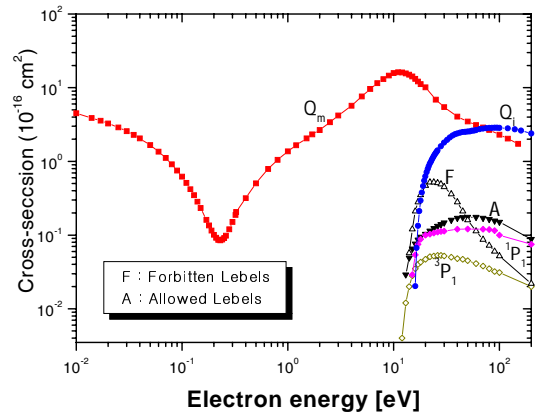


그림 3.2 Ar기체의 전자 충돌단면적
Fig.. 3.2 Collision cross sections of electrons in Ar gas

4. 결과 및 고찰

4.1 SF₆ 기체의 전리계수

전자에 의한 충돌전리는 전자가 전계 중에서 가속되어 전자의 운동에너지가 기체의 전리에너지를 넘으면 전리확률을 갖고 기체분자를 전리한다. 따라서 전자의 충돌전리의 크기를 정량적으로 나타내는 것을 전자의 충돌전리계수(α)라고 한다. 전리확률은 기체 내를 전자가 갖는 운동에너지 즉 전자가 평균자유행정 사이에서 얻은 에너지의 함수이므로 $\alpha/N = f(E/N)$ 으로 나타낸다[8].

그림 4.1은 SF₆ 기체의 전리계수를 나타낸 것으로 E/N값이 적은 영역에서는 α/N 은 거의 일정한 포화상태를 유지하나 E/N=100 [Td]이상의 영역에서는 α/N 은 급속히 증가하였음을 나타내었다.

이것은 SF₆ 기체의 특성 중에서 부착 단면적(Q_{a1}, Q_{a2})의 절대값이 크므로 전리에 의하여 발생한 전자는 높은 에너지상태에 도달하기가 힘들고 전리능력이 없다.

그러나 전자의 운동에너지가 기체의 전리에너지 보다 크게 되어 전리확률은 급격히 증가하였다. 이들의 계산 값을 A. V. Phelps and R. J. Van Brunt(1988), M. Hayashi and S. Hara(1991)들의 실험값과 비교하여 거의 일치한 값으로 나타냈다[9].

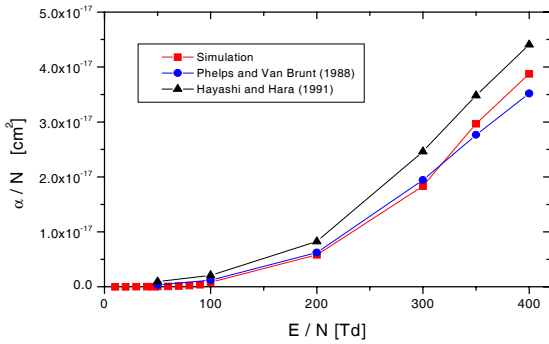


그림 4.1 SF₆ 기체의 전리계수
Fig. 4.1 The coefficients of ionization in SF₆

4.2. Ar 기체에서 전리계수

그림4.2는 Ar 기체에서 전리계수를 나타내며 실험치와 시뮬레이션 계산값과 Y. Suzuki[7]의 실험값을 나타내었으며, Y. Suzuki의 실험값은 낮은 E/N[Td] 영역에서는 나타나지 않았으나 E/N>50 [Td]에서는 시뮬레이션 실험값과 거의 같은 값으로 나타났고 결과적으로 낮은 E/N[Td]영역에서는 전리계수가 급격히 증가하였으나 높은 E/N[Td]영역에서는 거의 일정한 경향을 나타내는데 이러한 현상은 전자의 에너지가 증가하면 충돌할 때에 상호작용 시간이 너무 짧기 때문에 전리하기가 어렵기 때문이다.

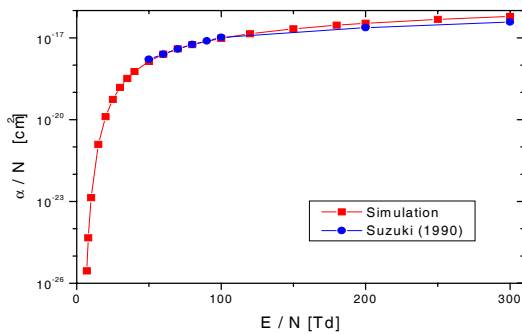


그림 4.2 Ar 기체의 전리계수
Fig. 4.2 The coefficient of ionization in Ar

4.3 SF₆ - Ar 혼합기체에서 전리계수

그림 4.3은 SF₆ - Ar 혼합기체 중에서 전리계수(α/N) 값을 갖는 E/N[Td]를 파라미터로 하여 혼합비에 따라 계산한 결과를 나타낸다.

본 연구에서 혼합기체 중의 전리계수(α/N)는 E/N과 혼합비의 증가에 따라 증가하는 경향이 나타났다.[9]~[11].

이것은 Ar기체의 Ramsauer Townsend Minimum을 갖는 운동량 변환 단면적, 비탄성 충돌 단면적의 영향과 SF₆ 기체의 큰 부착 단면적에 기인한다.

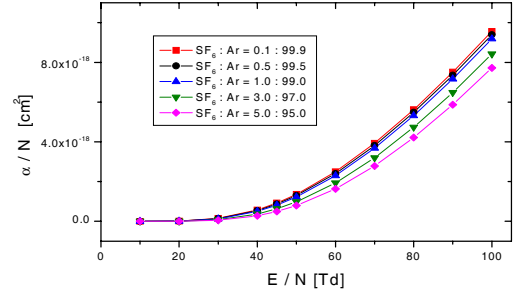


그림 4.3 SF₆ - Ar 혼합기체에서 전리계수
Fig. 4.3 The ionization coefficients in SF₆ - Ar mixtures

5. 결 론

본 연구는 탄성 및 비탄성 충돌 단면적과 전리증식의 전자군을 형성하는 비교적 낮은 E/N[Td] 영역에서 혼합기체의 혼합비에 따른 전리, 부착, 실효전리계수 및 전자 수송계수(Swarm parameter)를 볼츠만 방정식을 이용한 이론 해석과 몬테카를로 시뮬레이션에 의해 해석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

본 연구의 결과를 토대로 다양한 다른 기체에 대해서도 같은 과정을 통하여 전자의 수송 계수를 얻을 수 있을 것으로 확신한다. 이렇게 얻은 계수의 데이터를 바탕으로 새로운 고전압 전기재료의 물성적 기초 자료에 활용과 실제 기기의 설계에 적용, 기체 방전 모델을 확장한 정량적 해석도 가능할 것으로 생각한다. 특히 최근 주목되고 있는 펄스 코로나 방전을 이용한 오염 물질을 제거시키는 배기 가스 처리 문제에도 응용할 수 있다고 본다.

참 고 문 헌

- [1] L. G. H. Huxley & R. W. Cormpton. "The Diffusion and Drift of Electrons in Gases" John Wiley and Sons. Inc 1974.
- [2] H. Itoh, Y. Miura, N. Ikuta, Y. Nakao and H. Tagashira, "Electronswarm development in SF₆ : I. Boltzmann equation analysis" Phys. D:Appl. Phys 21, pp.922-930, 1988.
- [3] 電氣學會技術報告, "氣體放電シミュレーション技法" 第140號, 1974.
- [4] 몬테카를로법과 시뮬레이션, 培風館, 1989.
- [5] 谷口敏幸 *et al.*, "볼츠만方程式による運動量變換 斷面積の推定に關して." 放電研究會資料, ED-86-116, pp.39~49, 1986.
- [6] S. Trajmar, A. Chutjian, "electron impact excitation of SF₆" J. Phys. B, Vol.10, pp.2943 ~2949, 1977.
- [7] 하성철, 전병훈, 백승권, "몬테 카를로법을 이용한 Ar기체의 전자수송계수에 관한 연구", 한국전기전자재료학회지, Vol. 8, No. 6, pp. 685~692, 1995.
- [8] 河聖哲, 徐相賢, "SF₆가스의 電子輸送特性에 관한 몬테카를로 시뮬레이션", 韓國電氣電子材料學會誌, Vol. 9, No. 7, pp.660-667, 1996.
- [9] 金相南 "SF₆-Ar 混合氣體에서의 電離 및 附着係數에 관한研究" 工學博士學位論文, 東國大學校, 2000
- [10] 김상남, 하성철 "SF₆-Ar 혼합기체에서의 전리와 부착계수" 한국전기전자재료학회지, Vol. 14, No. 9, pp. 773~778, 2001.
- [11] 金相南, "MCS-BEQ 에 의한 SF₆-Ar혼합기체의 전자이동속도" 대한전기학회 논문집, 54P-1-5, pp.29~33, 2005